

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 5 月 18 日(18.05.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/063757 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *B24B 37/00* (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/075543
- (22) 国際出願日: 2011 年 11 月 7 日(07.11.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-250249 2010 年 11 月 8 日(08.11.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 フジミインコーポレーテッド(FUJIMI INCORPORATED) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 篠田 敏男 (SHINODA, Toshio) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 株式会社 フジミインコーポレーテッド 内 Aichi (JP). 永原 佳代子 (NAGAHARA, Kayoko) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 株式会社 フジミインコーポレーテッド 内 Aichi (JP). 井上 穰 (INOUE, Yutaka) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 株式会社 フジミインコーポレーテッド 内 Aichi (JP). 高橋 修平 (TAKAHASHI, Shuhei) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 株式会社 フジミインコーポレーテッド 内 Aichi (JP). 三輪 俊博 (MIWA, Toshihiro) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県

清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1 株式会社 フジミインコーポレーテッド 内 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 恩田 博宣, 外(ONDA, Hironori et al.); 〒5008731 岐阜県岐阜市大宮町 2 丁目 1 2 番地の 1 Gifu (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COMPOSITION FOR POLISHING AND METHOD OF POLISHING SEMICONDUCTOR SUBSTRATE USING SAME

(54) 発明の名称: 研磨用組成物およびそれを用いた半導体基板の研磨方法

(57) Abstract: Provided is a composition for polishing containing: abrasive grains; a compound of at least one kind of alcohol selected from aliphatic alcohol having 2 to 6 carbon atoms and glycol ether having 3 to 10 carbon atoms; at least one kind of basic compound selected from a salt of quaternary ammonium and an alkali metal salt; and water. The average primary particle diameter of the abrasive grains is 5 to 50 nm. The content of alcohol in the composition for polishing is 0.01 to 1% by mass. This composition for polishing is mainly used in an application for polishing a surface of a semiconductor substrate.

(57) 要約: 砥粒と、炭素数 2～6 の脂肪族アルコール及び炭素数 3～10 のグリコールエーテルから選ばれる少なくとも 1 種のアルコール化合物と、第四級アンモニウムの塩またはアルカリ金属塩から選ばれる少なくとも 1 種の塩基性化合物と、水と含有する研磨用組成物を提供する。前記砥粒の平均一次粒子径は 5～50 nm である。研磨用組成物中の前記アルコールの含有量は 0.01～1 質量%である。この研磨用組成物は、半導体基板の表面を研磨する用途で主に使用される。

WO 2012/063757 A1